

T.	Date come	rimentale prima	ne.		
1.1	2 Caract. o	le intrave / tri	unsfer	Cano	
ur. J	3 (µ4)	yc(mA)	VBE (V	)	
1	0	0	0		
2	0	0	0,28		
3	0	0	0,34		
4	0	0	0,47		
5	2	0,2	0,54	N X M	
6	6	0,6	0,57	082	A
A DE	14	1,3	0,59	2	V. 10 7 1.
8.	28	2,8	0,6	3 7 3 7	9, 4, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
9	42	4,4	0,62		
10	52	5,6	0,62	2 2 3	5
12	80	8,7	0,63		
	Prelucrarea				
11.1					
		Vbe(V			
	-0,1 0	,0 0,1 0,2 0,3		0,6 0	7,7
	80 -			•	- 80
	60 -			†	60
	<b>4</b>			İ	
	(Au)dl			1	40 (Vr) qI
	20 -			Ţ	- 20
	A WATER STATE				

0,2 0,3 0,4 Vbe(V)

0,5

0,6

0,7

0,1

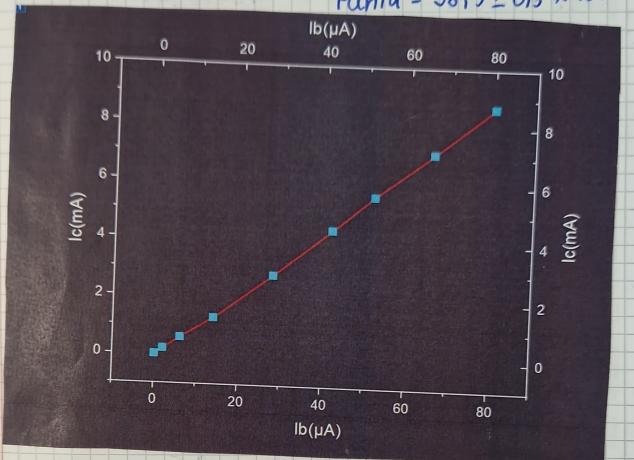
<del>1</del> -0,1

0,0

26

Panta = Factor B

Panta = 98,5 ± 0,5 × 100

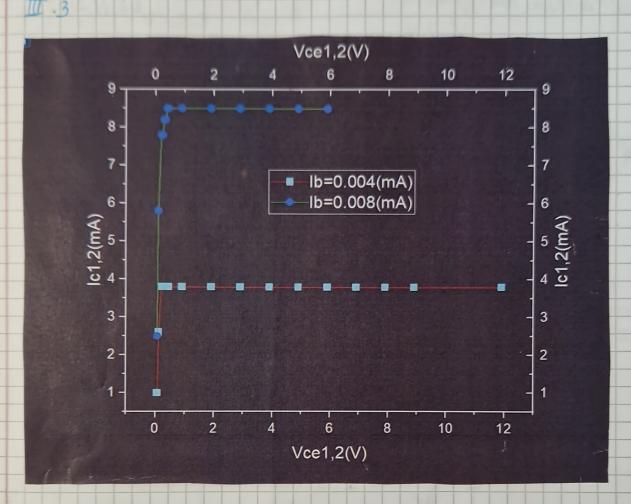


Masuram Jo, Jc, VBE. com grera in regiunea activà a transistorului, cesa cl inseamna tensiunea de polaritare directa pe jonctiunea emitorului si tensiunea de polaritare directa pe jonctiunea colectorului. Bupa acela, jutem observa caro deristicile statice pe care le presinta siste mul. La caracteristica de intrarl, aventul yc are o valo are mai mare de cat curentul yo, cela ce este pi normal.

Va caracteristica statia de intrare se poate vedea efectul Early.

Je d Je.

II 3. Caract de iesire 18=80 µA					
WR Ic(m#) VCE(V) WR Yc(m	A) VCE(V)				
1 0,06 1 2,5	0,06				
2 2,6 0,1 2 5,8	0,1				
3 3,8 0,2 3 4,8	0,16				
4 3.8 0,25 4 7,8	0,18				
5 3,8 0,3 5 8,2	0,25				
6 3,8 . 0,35 6 8,2	0,28				
7 3,8 0,4 7 8.5					
8 3,8 0,45 8 8,5					
9 3,8 0,91 9 8,5					
10 3,8 1,9 10 8,5	2,85				
11 318 2.9 11 8,5					
12 3,8 3,9 12 8,5	6,9				
13 3,8 . 4,9 . 13 8,5	A GARDINA.				
14 3,8 5,9 14 8,5	11,9				
15 318 6,9					
16 3,8 4,9					
17 3,8 8,9					
18 3,8 11,9	46				
	4 1				
28					



IV. Conduzie: In aceasta lucrare de laborator, am investigat caracteristicile statice ale transisto-rului în configurația emitar comun. Rezultatele ne-au permis să întelegem comportamentul transistorului ca amplificator și sa evidențiem importanta controlului precis al curenților și tensiunilor în aplicațile electronice.